www.DataSheet4U.com

2SB1065 エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ 低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp. Epitaxial Planar PNP Silicon Transistor

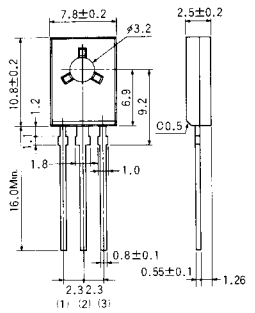
● 特長

1) $V_{CE(sat)}$=−0.5V (Typ.) と低い。 at I_C/I_B=−2A/−0.2A
2) ASOが広く破壊に強い。
3) 2SD1506とコンプリである。
4) 放熱器への取付けが容易にできる。

● Features

1) Low collector saturation voltage: $V_{CE(sat)}$=−0.5V(Typ.)I_C/I_B=2A/−0.2A
2) ASO is wide and highly resistant to breakdown.
3) Complementary pair with 2SD1506.
4) Easily mounted in radiator.

● 外形寸法図／Dimensions (Unit : mm)



(1) Emitter
(2) Collector
(3) Base

TO-126

● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−5	V
コレクタ電流	I_C	−3	A
		−4.5	A (Pulse)
コレクタ損失	P_C	10	W (Tc=25°C)
		1.2	W (Ta=25°C)
接合部温度	Tj	150	°C
保存温度範囲	Tstg	−55～150	°C

● 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	−50	−	−	V	I_C=−1mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	−60	−	−	V	I_C=−50μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	−5	−	−	V	I_E=−50μA
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	−	−	−1.0	μA	V_{CB}=−40V
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	−	−	−1.0	μA	V_{EB}=−4V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	−	−	−1.0	V	I_C/I_B=−2A/−0.2A
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	−	−	−1.5	V	I_C/I_B=−2A/−0.2A
直流電流増幅率	h_{FE}	56	−	390	−	V_{CE}/I_C=−3V/−0.5A
利得帯域幅積	f_T	−	70	−	MHz	V_{CE}=−5V, I_E=0.5A
出力容量	C_{ob}	−	50	−	pF	V_{CB}=−10V, I_E=0A, f=1MHz

h_{FE}の値により下表のように分類します。

Item	N	P	Q	R
h_{FE}	56～120	82～180	120～270	180～390

● 標準品・準標準品一覧表 (◎：標準品 ○：準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	バルク
		記号	
		基本発注単位(個)	1 000
2SB1065	NPQR		○